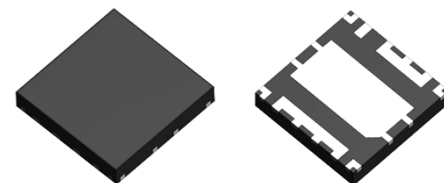


逆電流防止機能内蔵 Pch MOSFET MF2003SV V-Diode™

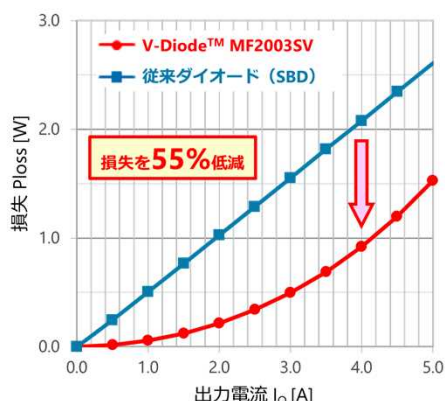


MF2003SV V-Diode™は逆接続保護・逆電流防止用の理想ダイオードICです。
Pch MOSFETと逆接続保護・逆電流防止回路を一体化することで、従来のダイ
オード(SBD)と比較して低損失化を実現しました。
また実装面積・部品点数の低減が可能なため機器の小型化にも貢献します。

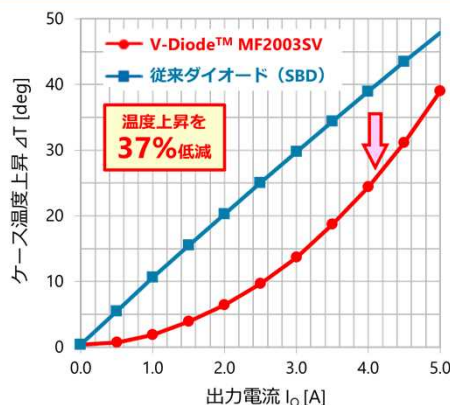


WSN8

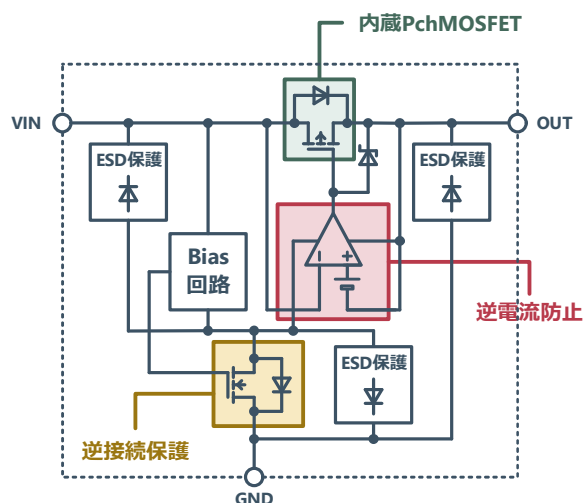
損失比較



温度上昇比較



ブロック図



	MF2003SV
パッケージ	WSN8-4040
動作電圧	2.5~40V
電流	5A
暗電流	≤3μA
内蔵MOS R_{on}	53mΩ (Typ.)
逆接続保護	内蔵
逆電流防止	25mVオフセットのコンパレータ
サージ順電流 I_{FSM}	70A
ターンオフ遅延時間 T_{off}	500ns (Typ.)

小型パッケージ

ウェットブル・フランク対応のリードレスパッケージ、WSN8(4.0mm□サイズ)を採用しています。

MF2003SV

V-Diode™
WSN8パッケージ

D15FR4ST

定格：40V/15A
FRパッケージ
(TO-252AA類似)

D30FDC4S

定格：40V/30A
FDパッケージ
(SC-83類似)



アクティブクランプ機能搭載

内蔵PchMOSFETのブレークダウン防止で、 $\Delta V_{DS} \approx 40V$ 程度でクランプする機能を搭載しています。

RoHS対応、ハロゲンフリー

新電元半導体製品の詳細情報はこちら

<https://www.shindengen.co.jp/products/semi/>

